

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet
Disciplina: OC - Organização de Computadores
Professor: Antônio Neco de Oliveira, Dr.

Data: 19/05/2023

OC10 - Memória Interna

VERDADEIRO OU FALSO

1.	(() O elemento básico de uma memória semicondutora é a célula de memória.				
2.	() Uma característica da ROM é que ela é volátil.				
3.	() A RAM deve ser fornecida com uma fonte de energia constante.				
4.	() As duas formas tradicionais de RAM usadas nos computadores são DRAM e SRAM.				
5.	() Uma RAM estática manterá seus dados enquanto a energia for fornecida.				
6.		($$) Não volátil significa que a energia deve ser fornecida continuamente à memória para preservar os valores dos bits.				
7.	(e n) A vantagem da RAM é que os dados ou o programa estão permanentemente na memória principal unca precisam ser carregados a partir de um dispositivo de armazenamento secundário.				
8.	() A memória semicondutora vem em chips embalados.				
9.	() Todas as DRAMs exigem uma operação de atualização.				
10.	() Uma série de chips podem ser agrupados para formar um banco de memória.				
11.	\) Um código de correção de erros aumenta a confiabilidade da memória ao custo da complexidade cionada.				
12.	() A DRAM é muito mais cara do que a SRAM.				
13.	() A memória flash é usada apenas para aplicações de memória interna.				
14.) A SDRAM funciona melhor quando transfere grandes blocos de dados sequencialmente, como cessamento de texto, planilhas e multimídia.				
15.) A memória NOR é mais adequada para memória externa, como drives flash USB e cartões de mória.				

MÚLTIPLA ESCOLHA

1.	Quais propriedades todas as células de memória semicondutora compartilham?								
	\bigcirc exibem dois estados estáveis que podem ser usados para representar binário 1 e 0.								
	O são capazes de ser escritas para definir o estado.								
	\bigcirc são capazes de ser l	o são capazes de ser lidas para sentir o estado.							
	O Todas as alternative	as anteriores.							
2.	Uma característica distintiva da memória que é designada como é que é possível ler os dados da memória e escrever novos dados nela de modo fácil e rápido.								
	○ RAM	○ ROM	○ EPROM	○ EEPROM					
3.	Qual dos seguintes tipos de memória não é volátil?								
	O PROM apagável		O memória flash						
	○ ROM programável		○ todas as alternativas anteriores						
4.	Em uma, os valores binários são armazenados usando configurações de porta lógica-porta flip-flop tradicionais.								
	\bigcirc ROM	○ SRAM	○ DRAM	○ RAM					
5.	Uma contém um padrão permanente de dados que não podem ser alterados, não são voláteis e não podem ter dados novos neles escritos.								
	\bigcirc RAM	○ SRAM	○ ROM	O memória flash					
6.	Com a o microchip é organizado para que uma seção de células de memória seja apagada em uma única ação.								
	memória flash	\bigcirc SDRAM	○ DRAM	○ EEPROM					
7.	Os podem ser causados por severos abusos ambientais, defeitos de fabricação e desgaste.								
	○ Erros SEC		○ Erros de síndrome						
	Erros permanentes		○ Erros não permanentes						
8.	Os podem ser causados por problemas de fornecimento de energia ou partículas alfa.								
	O Erros não permane	ntes	○ Erros permanentes						
	○ Erros AGT		○ Erros SEC						

9.	A troca dados com o processador sincronizado com um sinal de clock externo e executando					
	a toda velocidade do proce	essador/barramento de	memória sem impor estac	los de espera.		
	○ DDR-DRAM		\bigcirc CDRAM			
	\bigcirc SDRAM		O nenhuma das alt	ernativas anteriores		
10.	Com a a transferência de dados é sincronizada tanto para a margem ascendente como descendente do clock, em vez de apenas a margem ascendente.					
	\bigcirc CDRAM	\bigcirc SDRAM	○ DDR-DRAM	\bigcirc RDRAM		
11.	aumenta a taxa de transferência de dados elevando a frequência operacional do chip RAM e aumentando o buffer de pré-busca de 2 bits para 4 bits por chip.					
	○ DDR2	○ RDRAM	\bigcirc CDRAM	○ DDR3		
12.	aumenta o tamanho do buffer de pré-busca para 8 bits.					
	○ CDRAM		○ DDR3			
	\bigcirc RDRAM		○ todas as alternat	ivas anteriores		
13.	Teoricamente, um módulo DDR pode transferir dados a uma taxa de clock na faixa de Mbps.					
	O 200 a 400	\bigcirc 400 a 1.066	○ 600 a 1.400	○ 800 a 16.00		
14.	Um módulo DDR3 transfere dados a uma taxa de clock de Mbps.					
	○ 600 a 1.200	○ 800 a 2.133	\bigcirc 1.000 a 2.000	○ 1.500 a 3.000		
15.	Uma é uma boa candidata para substituir ou complementar DRAM para memória principal.					
	○ STT-RAM	\bigcirc ReRAM	○ RamBus	○ PCRAM		